

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成16年8月12日(2004.8.12)

【公開番号】特開2002-255695(P2002-255695A)

【公開日】平成14年9月11日(2002.9.11)

【出願番号】特願2001-59195(P2001-59195)

【国際特許分類第7版】

C 3 0 B 29/40

G 1 1 B 11/105

【F I】

C 3 0 B 29/40 A

G 1 1 B 11/105 5 0 6 Z

【手続補正書】

【提出日】平成15年7月18日(2003.7.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

GaAs, InAs, InP, またはGaPよりなる群から選ばれるIII-V族系化合物において、VまたはCrよりなる群から選ばれる少なくとも1種の遷移金属がIII族元素を置換して混晶を形成してなることを特徴とする単結晶強磁性III-V族系化合物。